Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0400U003229

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-12-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ханова Ганна Владиславівна
2. Khanova Ganna Vladyslavivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.01

Назва наукової спеціальності: Фізика приладів, елементів і систем

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 17-11-2000

Спеціальність за освітою: 7/090803

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 26.199.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки 41, 03028, м. Київ-28

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 59.31.33, 59.31.35

Тема дисертації:

1. Розробка фізико-технологічних основ отримання плівок сульфіду самарию для тензорезисторів і дослідження їх параметрів

2. Development of physico-technological bases manufacturing of samarium sulphide films for strain gages and study of their parameters

Реферат/анотація:

1. Хімічним методом розпаду хелатних сіркумістячих метало-органічних сполук із синтезованих та досліджених dtc-комплексів самарію отримано полікристалічні текстуровані плівки ряду сульфіду самарію. Визначено умови для отримання плівок моносульфіду самарію кубічної модифікації, а також умови, які забеспечують відтворюване отримання вакуумною технологією плівок SmS з високою тензочутливістю. Досліджено рекомбінаційні параметри і механізми струмпроходження в тонкоплівкових структурах моносульфіду самарію, а також вплив матеріалу контактів на властивості цих структур. Визначено метрологічні характеристики напівпровідникових плівок на основі SmS і сформульовано основні особливості топології напівпровідникових плівок із SmS, показано деякі їх переваги перед металевими фольговими тензорезисторами.

2. By the chemical method of decomposition of sulphide containing chelate metalorganic compounds the polycrystalline textured films of samarium sulphide line have been received from the synthesised and investigated complexes of samarium. Both the conditions for cubic monosulphide samarium manufacturing and ones for high tensosensitive reproducible SmS films obtained by vacuum techniques have been determined. Recombination parameters, charge flow mechanisms and influence of a material of contacts in thin-films structures on the base of samarium monosulphide have been investigated. Metrological characteristics of samarium semiconductings films have been determined, the main features of topology of SmS semiconducting strain gages are formulated and some advantages of such strain gages in comparison with metal foil strain gages have been shown.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Свєчніков С.В.

2. Свєчніков С.В.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 05.27.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Романюк Б.М.

2. Романюк Б.М.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Морозовський М.В.

2. Морозовський М.В.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Шейнкман М.К.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Шейнкман М.К.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.